

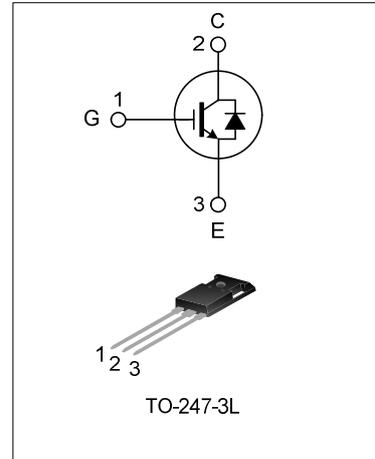
40A、1200V绝缘栅双极型晶体管

描述

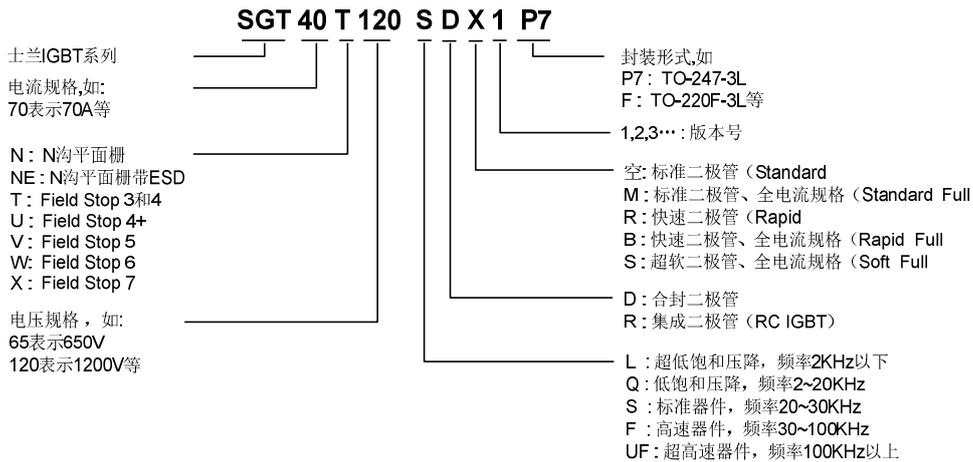
SGT40T120FD1P7 绝缘栅双极型晶体管采用士兰微电子第四代槽栅场截止 (Trench Field Stop) 工艺制作, 具有低的导通损耗和开关损耗, 正温度系数易于并联应用等特点。该产品可应用于感应加热, UPS, SMPS 以及 PFC 等领域。

特点

- ◆ 40A, 1200V, $V_{CE(sat)}(\text{典型值})=2.1V@I_C=40A$
- ◆ 低导通损耗
- ◆ 超快开关速度
- ◆ 高击穿电压



命名规则



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装
SGT40T120FD1P7	TO-247-3L	40T120FD1	无铅	料管

极限参数(除非特殊说明, $T_c=25^\circ\text{C}$)

参 数		符 号	参数范围	单 位
集电极-射极电压		V_{CE}	1200	V
栅极-射极电压		V_{GE}	± 20	V
集电极电流	$T_c=25^\circ\text{C}$	I_C	80	A
	$T_c=100^\circ\text{C}$		40	A
集电极脉冲电流		I_{CM}	120	A
耗散功率 ($T_c=25^\circ\text{C}$)		P_D	570	W
- 大于 25°C 每摄氏度减少			3.8	$\text{W}/^\circ\text{C}$
工作结温		T_J	$-55\sim+175$	$^\circ\text{C}$
贮存温度		T_{stg}	$-55\sim+175$	$^\circ\text{C}$

热阻特性

参 数	符 号	参数范围	单 位
芯片对管壳热阻 (IGBT)	$R_{\theta JC}$	0.26	$^\circ\text{C}/\text{W}$
芯片对管壳热阻 (FRD)	$R_{\theta JC}$	1.3	$^\circ\text{C}/\text{W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	40	$^\circ\text{C}/\text{W}$

IGBT 电性参数(除非特殊说明, $T_c=25^\circ\text{C}$)

参 数	符 号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单 位
集射击穿电压	BV_{CE}	$V_{GE}=0\text{V}, I_C=1\text{mA}$	1200	--	--	V
集射漏电流	I_{CES}	$V_{CE}=1200\text{V}, V_{GE}=0\text{V}$	--	--	500	μA
栅射漏电流	I_{GES}	$V_{GE}=20\text{V}, V_{CE}=0\text{V}$	--	--	± 400	nA
栅极开启电压	$V_{GE(th)}$	$I_C=4.0\text{mA}, V_{CE}=V_{GE}$	3.5	6.0	7.5	V
饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=40\text{A}, V_{GE}=15\text{V}$	--	2.1	2.5	V
		$I_C=40\text{A}, V_{GE}=15\text{V}, T_c=125^\circ\text{C}$	--	2.4	--	V
输入电容	C_{ies}	$V_{CE}=30\text{V}$	--	5400	--	pF
输出电容	C_{oes}	$V_{GE}=0\text{V}$	--	212	--	
反向传输电容	C_{res}	$f=1\text{MHz}$	--	93	--	
开启延迟时间	$T_{d(on)}$	$V_{CE}=600\text{V}$ $I_C=40\text{A}$ $R_g=10\Omega$	--	42	--	ns
开启上升时间	T_r		--	54	--	
关断延迟时间	$T_{d(off)}$		--	290	--	
关断下降时间	T_f		--	160	--	
导通损耗	E_{on}	$V_{GE}=15\text{V}$	--	2.8	--	mJ
关断损耗	E_{off}	感性负载	--	1.9	--	
开关损耗	E_{st}		--	4.7	--	
栅电荷	Q_g	$V_{CE}=600\text{V}, I_C=40\text{A},$ $V_{GE}=15\text{V}$	--	270	--	nC
发射极栅电荷	Q_{ge}		--	60	--	
集电极栅电荷	Q_{gc}		--	136	--	

FRD 电性参数(除非特殊说明, $T_C=25^{\circ}\text{C}$)

参 数	符 号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
二极管正向压降	V_{fm}	$I_F = 25\text{A}, T_C=25^{\circ}\text{C}$	--	2.3	3.1	V
		$I_F = 25\text{A}, T_C=125^{\circ}\text{C}$	--	2.1	--	
二极管反向恢复时间	T_{rr}	$I_{ES} = 25\text{A}, di_{ES}/dt = 200\text{A}/\mu\text{s}$	--	130	--	ns
二极管反向恢复电荷	Q_{rr}	$I_{ES} = 25\text{A}, di_{ES}/dt = 200\text{A}/\mu\text{s}$	--	0.92	--	μC

典型特性曲线

图1. 典型输出特性

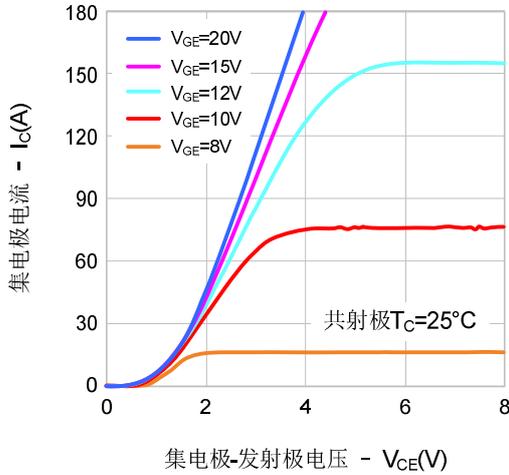


图2. 典型输出特性

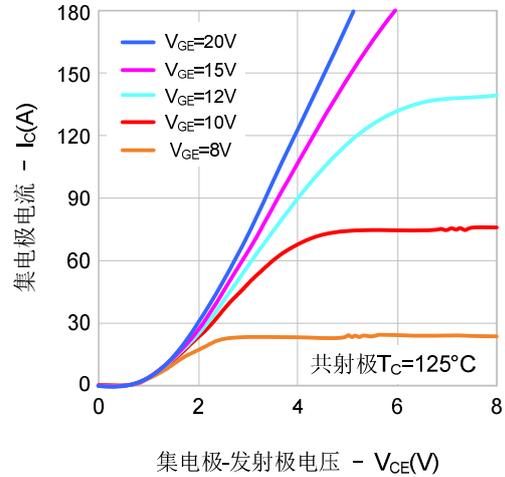


图3. 典型饱和电压特性

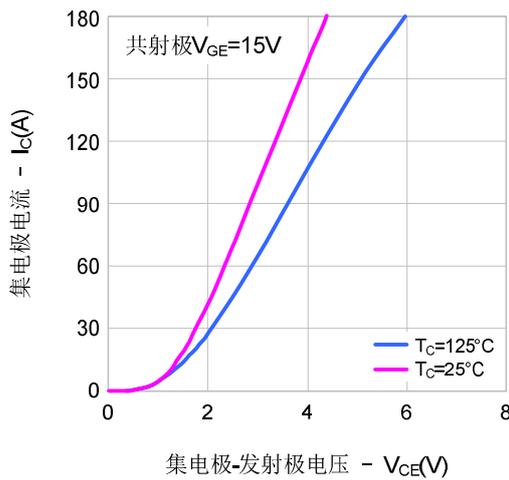


图4. 传输特性

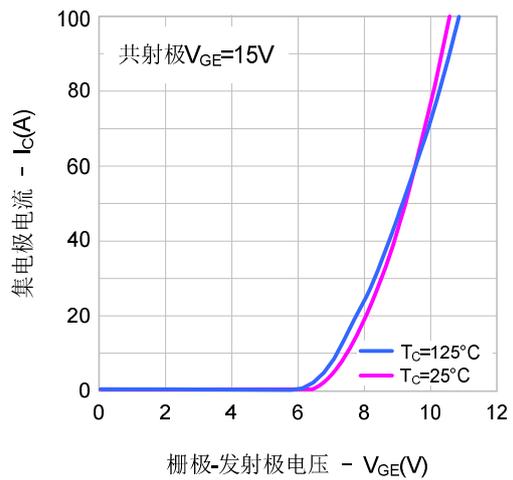


图5. 饱和电压 vs. 栅极-发射极电压

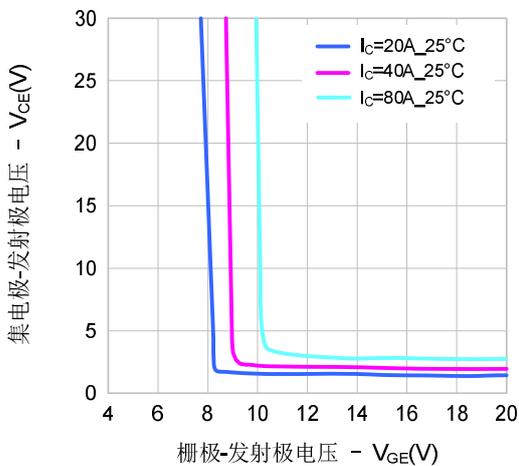
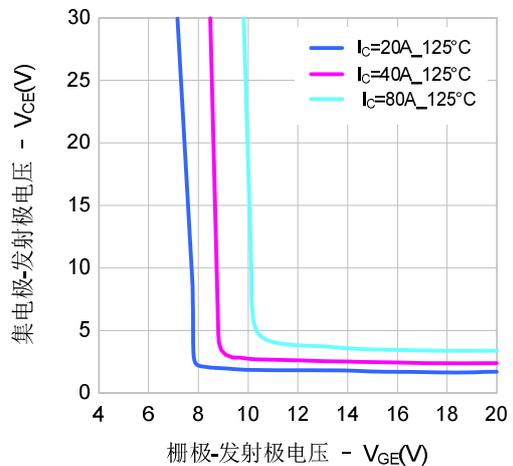


图6. 饱和电压 vs. 栅极-发射极电压



典型特性曲线 (续)

图7. 电容特性

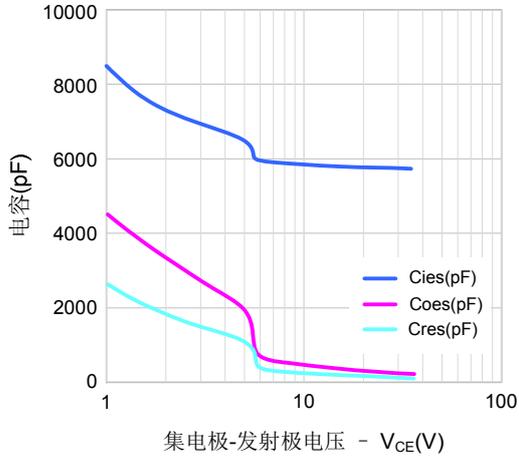


图8. 栅极电荷特性

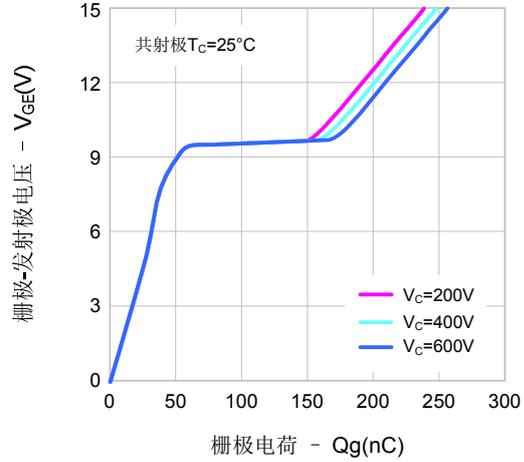


图9. 开启特性 vs. 栅极电阻

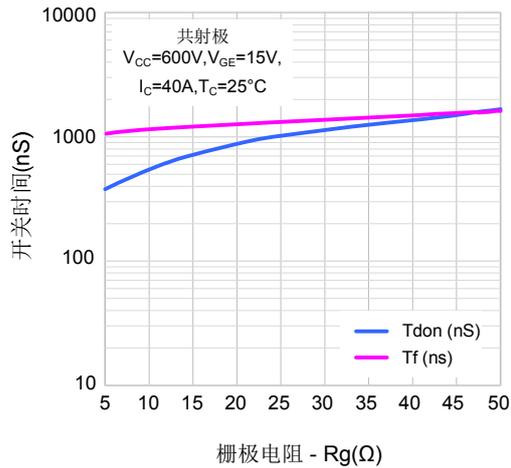


图10. 关断特性 vs. 栅极电阻

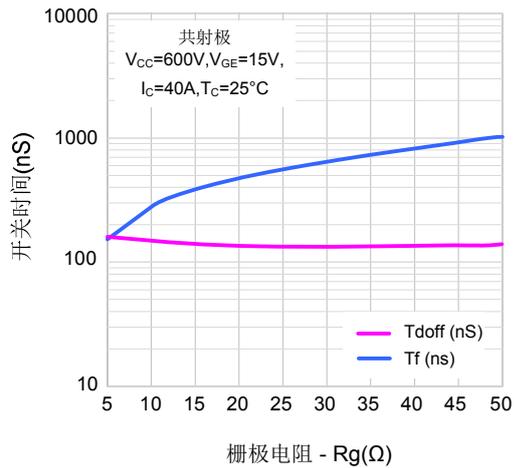


图11. 开关损耗vs栅极电阻

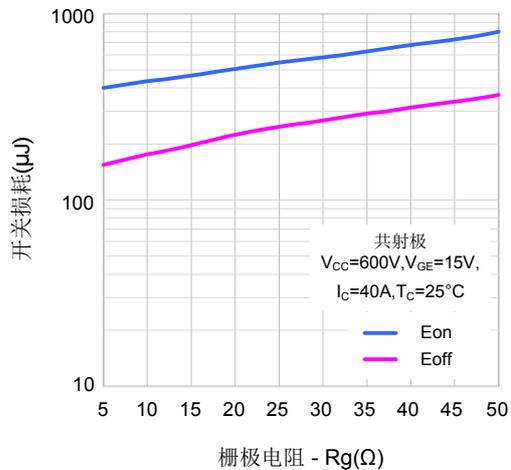
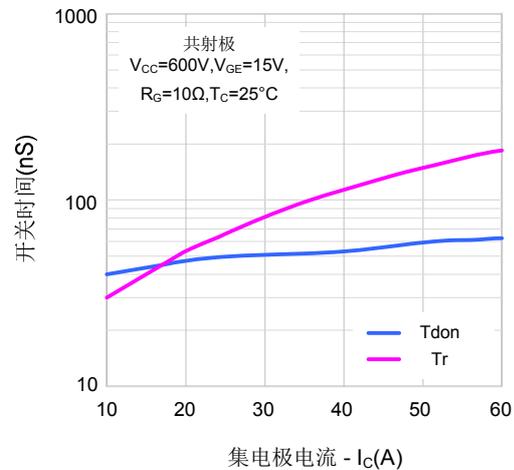


图12. 开启特性vs集电极电流



典型特性曲线 (续)

图13. 关断特性vs集电极电流

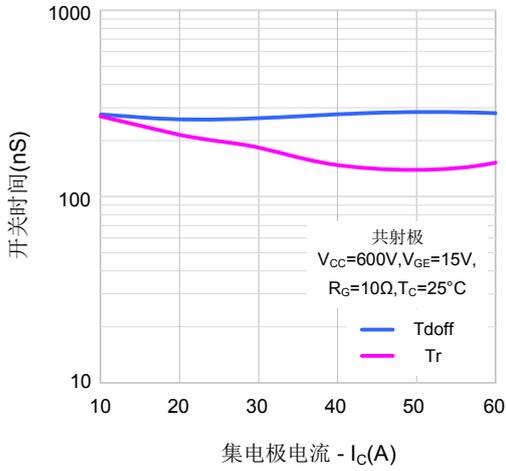


图14. 关断损耗vs集电极电流

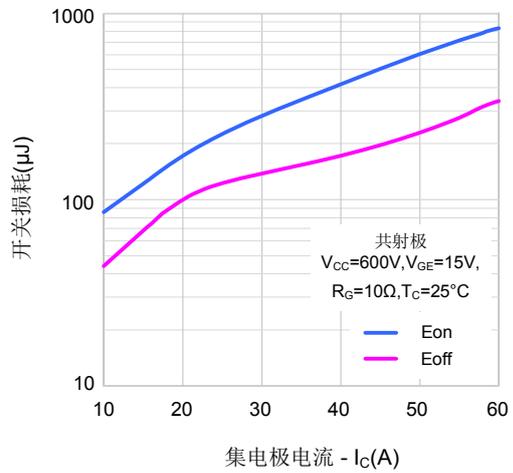


图15. 正向特性

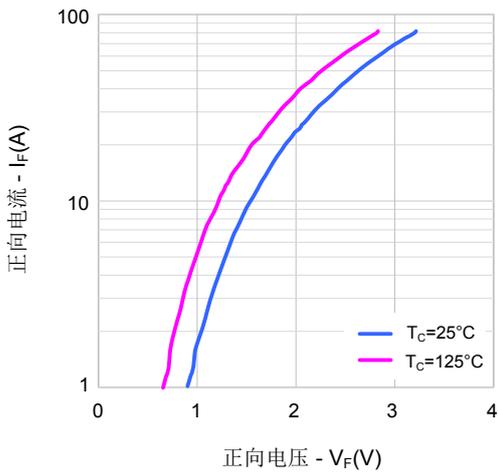


图16. 反向恢复时间vs正向电流

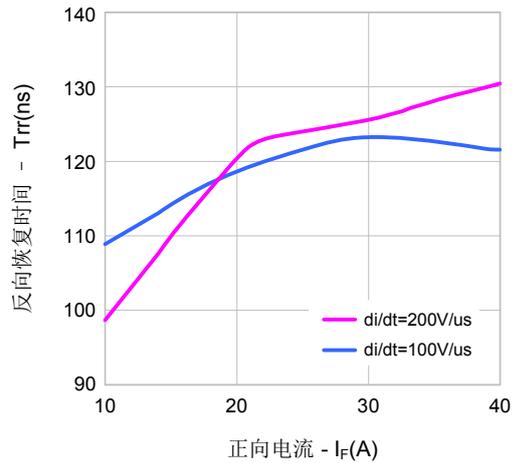


图17. 反向恢复电荷vs正向电流

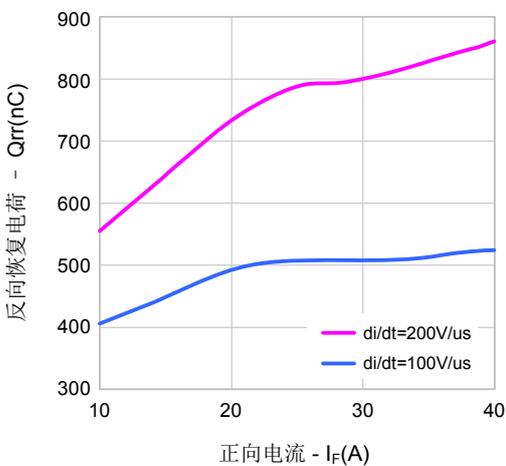
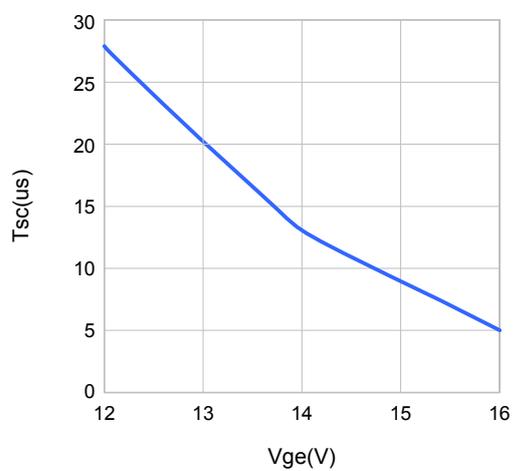
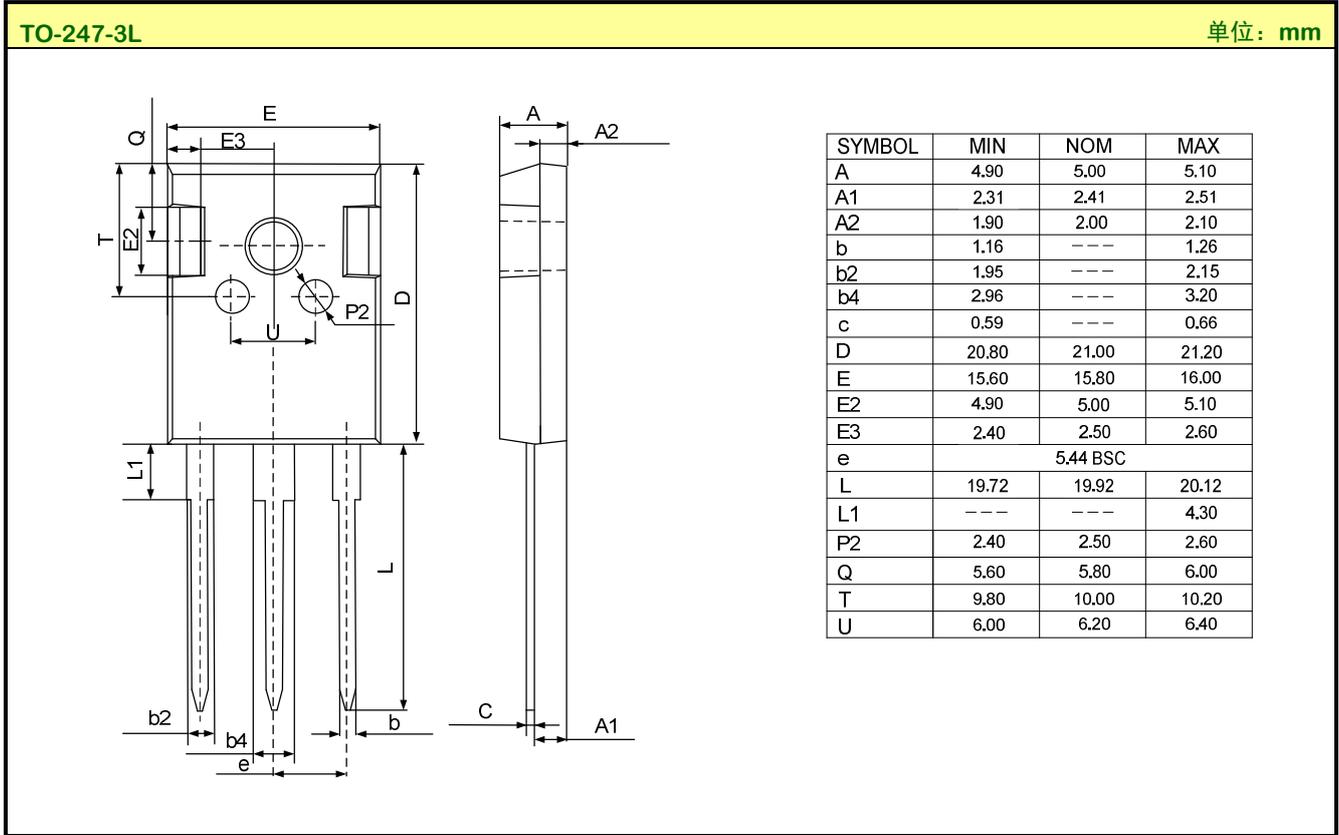


图18. Tsc(Vce=600V)



封装外形图



声明:

- ◆ 士兰保留说明书的更改权, 恕不另行通知! 客户在下单前应获取最新版本资料, 并验证相关信息是否完整和最新。
- ◆ 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能, 买方有责任在使用 **Silan** 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!
- ◆ 产品提升永无止境, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!

产品名称:	SGT40T120FD1P7	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版 本: 1.3

修改记录:

1. 更新命名规则
 2. 更新电气参数
 3. 更新图 7
 4. 更新 TO-247-3L 封装外形图
-

版 本: 1.2

修改记录:

1. 增加图 18
-

版 本: 1.1

修改记录:

1. 修改极限参数
-

版 本: 1.0

修改记录:

1. 正式版本发布
-